

## 特許協力条約に基づく国際出願願書

紙面による写し (注意 電子データが原本となります)

0	受理官庁記入欄	
0-1	国際出願番号	PCT/IB2018/056380
0-2	国際出願日	2018年 08月 23日 (23.08.2018)
0-3	(受付印)	RO/IB
0-4	様式 PCT/RO/101 この特許協力条約に基づく国際出願願書は、	
0-4-1	右記によって作成された。	PCT-SAFE Version 3.51.083.259 MT/FOP 20180701/0.20.5.24
0-5	申立て 出願人は、この国際出願が特許協力条約に従って処理されることを請求する。	
0-6	出願人によって指定された受理官庁	世界知的所有権機関国際事務局 (RO/IB)
0-7	出願人又は代理人の書類記号	PCT000027162
I	発明の名称	画像処理方法および半導体装置、ならびに電子機器
II	出願人	
II-1	この欄に記載した者は	出願人である (applicant only)
II-2	右の指定国についての出願人である。	すべての指定国 (all designated States)
II-4ja	名称	株式会社半導体エネルギー研究所
II-4en	Name:	SEMICONDUCTOR ENERGY LABORATORY CO., LTD.
II-5ja	あて名	2430036 日本国 神奈川県厚木市長谷398
II-5en	Address:	398, Hase, Atsugi-shi, Kanagawa 2430036 Japan
II-6	国籍(国名)	日本国 JP
II-7	住所(国名)	日本国 JP
II-8	電話番号	0462481131
II-9	ファクシミリ番号	0462702408
II-10	電子メール	gaikoku-info@sel.co.jp
II-10(a)	電子メール使用の承認 受理官庁、国際調査機関、国際事務局若しくは国際予備審査機関が、その官庁又は機関が希望する場合には、この電子メールアドレスを利用して、この国際出願に関する通知を送付することを承認する。	通知の写しを事前に送付するために利用することを承認する。

## 特許協力条約に基づく国際出願願書

紙面による写し (注意 電子データが原本となります)

III-1	その他の出願人又は発明者	
III-1-1	この欄に記載した者は	発明者である (inventor only)
III-1-4ja	氏名(姓名)	塩川 将隆
III-1-4en	Name (LAST, First):	SHIOKAWA, MASATAKA
III-1-5ja	あて名	2430036 日本国 神奈川県厚木市長谷398株式会社半導体エネルギー 研究所内
III-1-5en	Address:	c/o SEMICONDUCTOR ENERGY LABORATORY CO., LTD., 398, Hase, Atsugi-shi, Kanagawa 2430036 Japan
III-2	その他の出願人又は発明者	
III-2-1	この欄に記載した者は	発明者である (inventor only)
III-2-4ja	氏名(姓名)	玉造 祐樹
III-2-4en	Name (LAST, First):	TAMATSUKURI, YUKI
III-2-5ja	あて名	2430036 日本国 神奈川県厚木市長谷398株式会社半導体エネルギー 研究所内
III-2-5en	Address:	c/o SEMICONDUCTOR ENERGY LABORATORY CO., LTD., 398, Hase, Atsugi-shi, Kanagawa 2430036 Japan
V	国の指定	
V-1	この願書を用いてされた国際出願は、規則4.9(a)に基づき、国際出願の時点で拘束される全てのPCT締約国を指定し、取得しうるあらゆる種類の保護を求め、及び該当する場合には広域と国内特許の両方を求める国際出願となる。	
VI-1	先の国内出願に基づく優先権主張	
VI-1-1	出願日	2017年 09月 04日 (04.09.2017)
VI-1-2	出願番号	2017-169609
VI-1-3	国名	日本国 JP
VI-2	優先権証明書送付の請求	
	国際事務局に対して、上記の先の出願のうち、右記のものについては、該当する場合には記載されたアクセスコードを利用し、優先権書類に記載されている事項に係る情報を電子図書館から、取得することを請求する。	VI-1 アクセスコード : EEE6
VI-3	引用による補充 :	
	条約第11条(1)(iii)(d)若しくは(e)に規定する国際出願の要素の全部、又は規則20.5(a)に規定する明細書、請求の範囲若しくは図面の一部がこの国際出願には含まれていないが、受理官庁が条約第11条(1)(iii)に規定する要素の1つ以上を最初に受領した日において優先権を主張する先の出願にそれが完全に含まれている場合には、規則20.6に基づき確認の手続を条件として、その要素又は部分を規則20.6の規定によりこの国際出願に引用して補充することを請求する。	

## 特許協力条約に基づく国際出願願書

紙面による写し (注意 電子データが原本となります)

VII-1	特定された国際調査機関(ISA)	日本国特許庁 (ISA/JP)	
VIII	申立て	申立て数	
VIII-1	発明者の特定に関する申立て	-	
VIII-2	出願し及び特許を与えられる国際出願日における出願人の資格に関する申立て	-	
VIII-3	先の出願の優先権を主張する国際出願日における出願人の資格に関する申立て	-	
VIII-4	発明者である旨の申立て(米国を指定国とする場合)	-	
VIII-5	不利にならない開示又は新規性喪失の例外に関する申立て	-	
IX	照合欄	用紙の枚数	添付された電子データ
IX-1	願書(申立てを含む)	4	✓
IX-2	明細書	50	✓
IX-3	請求の範囲	2	✓
IX-4	要約	1	✓
IX-5	図面	26	✓
IX-7	合計	83	
	添付書類	添付	添付された電子データ
IX-8	手数料計算用紙	-	✓
IX-18	PCT-SAFE 電子出願	-	-
IX-20	要約とともに提示する図の番号	1	
IX-21	国際出願の使用言語名	日本語	
X-1	出願人、代理人又は代表者の記名押印	(PKCS7 デジタル署名)	
X-1-1	名称	株式会社半導体エネルギー研究所	
X-1-2	署名者の氏名	山崎舜平	
X-1-3	権限(署名者が法人の場合)	代表取締役社長	

## 受理官庁記入欄

10-1	国際出願として提出された書類の実際の受理の日	2018年 08月 23日 (23.08.2018)
10-2	図面	
10-2-1	受理された	
10-2-2	不足図面がある	
10-3	国際出願として提出された書類を補完する書類又は図面であつてその後期間内に提出されたものの実際の受理の日(訂正日)	
10-4	特許協力条約第11条(2)に基づく必要な補完の期間内の受理の日	
10-5	出願人により特定された国際調査機関	ISA/JP
10-6	調査手数料未払いにつき、国際調査機関に調査用写しを送付していない	

特許協力条約に基づく国際出願願書

紙面による写し (注意 電子データが原本となります)

国際事務局記入欄

11-1	記録原本の受理の日	
------	-----------	--